

映像情報メディア学会技術報告目次

[情報センシング]

イメージセンサおよび一般, 2015 IISWとVLSIシンポジウムからの発表報告

9月18日(金)

- IST2015-43 像面位相差AFと撮像とを全画素で両立した低ノイズ・高感度CMOSイメージセンサ
----- 小林昌弘・ジョンソン道子・和田洋一・坪井宏政・高田英明・都甲憲二・
岸 隆史・高橋秀和・市川武史・井上俊輔(キヤノン)--- 1
- IST2015-44 A 4M pixel full-PDAF CMOS Image Sensor with 1.58 μ m 2x1 On-Chip Micro-Split-Lens Technology
---- Atsushi Morimitsu・Isao Hirota・Sozo Yokogawa・Isao Ohdaira・Masao Matsumura・
Hiroaki Takahashi・Toshio Yamazaki・Hideki Oyaizu(Sony),
Yalcin Incesu・Muhammad Atif(Sony Deutschland), Yoshikazu Nitta(Sony)--- 5
- IST2015-45 1600万画素グローバルシャッターモード搭載の400万マイクロバンプ接続積層イメージセンサ
----- 近藤 亨・竹本良章・小林賢司・月村光宏・高澤直裕・鈴木俊介・加藤秀樹・
青木 潤・齋藤晴久・五味祐一・松田成介・只木芳隆(オリンパス)--- 9
- IST2015-46 The source decomposition of dark FPN and its improvement by stacked CIS process
Yuichiro Yamashita・Wen-hau Wu・Wen-jen Chiang・Chi-hsien Chung・Ren-jie Lin・
Jhy-nyi Sze・Jen-cheng Liu・Cheng-hsien Tseng・Hirohumi Sumi(TSMC), Sho-gwo Wu--- 13
- IST2015-47 磁界結合を用いた高速・低ノイズ3次元集積イメージセンサ
池辺将之・内田大輔(北大), 竹 康宏(慶大), 染谷慎人・築田聡史・松山健人・浅井哲也(北大),
黒田忠広(慶大), 本村真人(北大)--- 17
- IST2015-48 [招待講演] スマートホン向けのイメージセンサに望むこと ~画素特性とその改善~
----- 小林 篤(華為技術日本)--- 21
- IST2015-49 DMOSキャパシタを用いた3,300万画素、120Hz、14ビットCMOSイメージセンサの開発
---- 安江俊夫・北村和也・渡部俊久・島本 洋(NHK), 小杉智彦・渡辺恭志・
青山 聡(ブルックマンテクノロジ), 物井 誠(東芝), Zhiheng Wei(静岡大),
川人祥二(ブルックマンテクノロジ/静岡大)--- 25
- IST2015-50 8K 120fps SHVイメージセンサ用2段サイクリック型ADCの高精度・動的デジタル補正に関する基礎実験
----- 渡部俊久・北村和也(NHK), 小杉智彦(ブルックマンテクノロジ),
大竹 浩・島本 洋(NHK), 川人祥二(静岡大/ブルックマンテクノロジ)--- 29
- IST2015-51 結晶性酸化半導体回路とアバランシェ増倍型光電変換膜を用いた高感度イメージセンサ
黒川義元・中川貴史・前田修平・王丸拓郎・池田隆之・鈴木康太・山出直人・
宮入秀和(半導体エネルギー研), 為村成亨・菊地健司・宮川和典・大竹 浩・久保田節(NHK),
池田 誠(東大), 山崎舜平(半導体エネルギー研)--- 33
- IST2015-52 バックゲート表面電位固定構造を用いた完全空乏化SOIピクセル検出器の性能評価
----- 亀濱博紀・Sumeet Shrestha・安富啓太・香川景一郎(静岡大),
武田彩希・鶴 剛(京大), 新井康夫(高エネ研), 川人祥二(静岡大)--- 37
- IST2015-53 Toward 10 Gfps: Factors Limiting the Frame Rate of the BSI MCG Image Sensor
Dao Vu Truong Son・Quang Nguyen Anh・Kotaro Kitagawa・Kazuhiro Shimonomura・
Takeharu Etoh(Ritsumeikan Univ.), Natsumi Minamitani・Yoshinari Kamakura(Osaka Univ.)--- 41
- IST2015-54 高性能イメージセンサへのマイクロ波アニールによるイオン注入損傷回復
木村雅俊(ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング), 山口 直(ルネサスエレクトロニクス),
黒井 隆(ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング)--- 45
- IST2015-55 電荷電圧変換ゲイン240uV/e⁻、飽和電子数200ke⁻、感度波長帯域190-1000nmを有する
CMOSイメージセンサ
----- 那須野悟史・若嶋駿一・楠原史章・黒田理人・須川成利(東北大)--- 49
- IST2015-56 フローティングディフュージョン容量成分の解析・低減技術と高感度・高飽和CMOSイメージセンサ
への適用
----- 楠原史章・若嶋駿一・那須野悟史・黒田理人・須川成利(東北大)--- 53